

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成30年11月1日(2018.11.1)

【公開番号】特開2017-223815(P2017-223815A)

【公開日】平成29年12月21日(2017.12.21)

【年通号数】公開・登録公報2017-049

【出願番号】特願2016-118475(P2016-118475)

【国際特許分類】

G 09 F 9/30 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

H 01 L 21/336 (2006.01)

【F I】

G 09 F 9/30 3 3 8

H 01 L 29/78 6 1 6 S

H 01 L 29/78 6 1 6 V

H 01 L 29/78 6 1 6 T

H 01 L 29/78 6 1 8 B

H 01 L 29/78 6 1 9 A

H 01 L 29/78 6 1 6 L

【手続補正書】

【提出日】平成30年8月28日(2018.8.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 8】

一方、上部電極17bは、例えばその端部e1が、酸化物半導体層15の一部に重なるように成形される。このとき、上部電極17bは、その端部e1が絶縁膜16bの端部e2よりも張り出して形成される(端部e2が端部e1よりも後退した位置に形成される)ように加工される。また、加工条件により、端部e1のエッジ形状(側面の形状)および幅等を調整することで、上述のように、低抵抗領域15bのオーバーラップ領域15b1の幅Dを制御することも可能である。尚、図9等の図面では、上部電極17bの端部e1のエッジ(側面)は、基板面に対して垂直な面としているが、傾斜面であってもよい。